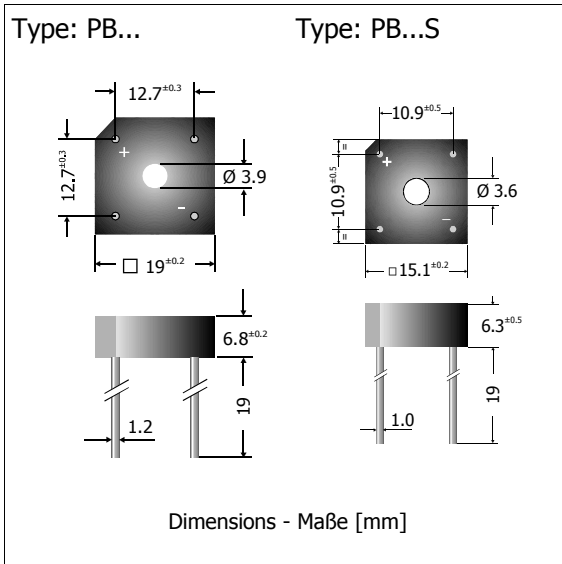


PB1000 ... PB1010, PB1000S ... PB1010S

Silicon-Bridge-Rectifiers Silizium-Brückengleichrichter

Version 2011-03-22



Nominal current – Nennstrom	10 A
Alternating input voltage Eingangswchelsspannung	35...700 V
Type: PB... Plastic case – Kunststoffgehäuse Weight approx. – Gewicht ca.	19 x 19 x 6.8 [mm] 5.5 g
Type: PB...S Plastic case with Al-bottom – Kunststoffgehäuse mit Alu-Boden Weight approx. – Gewicht ca.	15.1 x 15.1 x 6.3 [mm] 3.5 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswchelspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾
PB1000 / PB1000S	35	50
PB1001 / PB1001S	70	100
PB1002 / PB1002S	140	200
PB1004 / PB1004S	280	400
PB1006 / PB1006S	420	600
PB1008 / PB1008S	560	800
PB1010 / PB1010S	700	1000

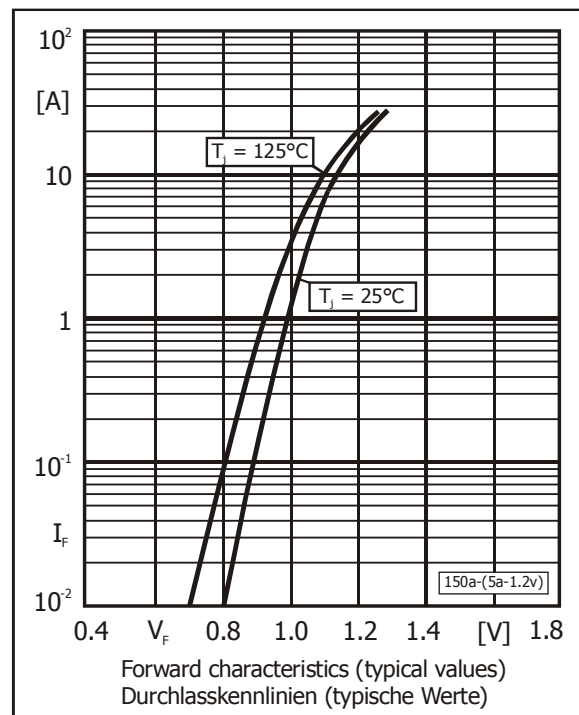
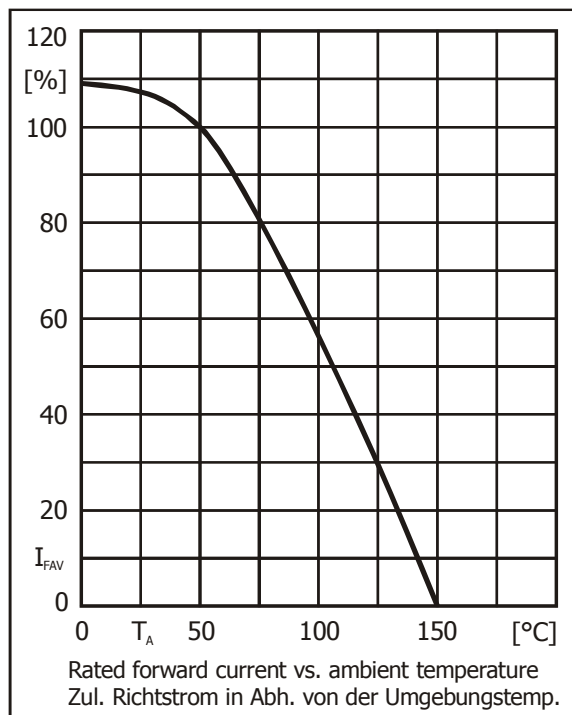
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	I_{FRM}	50 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	135/150 A ¹⁾
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	93 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ²	T _A = 50°C	R-load C-load	I _{FAV}	10.0 A 8.0 A
Forward voltage Durchlass-Spannung	T _J = 25°C	I _F = 5 A	V _F	< 1.2 V ¹⁾
Leakage current Sperrstrom	T _J = 25°C	V _R = V _{RRM}	I _R	< 10 μA
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			V _{ISO}	> 2500 V
Thermal Resistance Junction – Case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R _{thC}	< 3.3 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		M 4		9 ± 10% lb.in 1 ± 10% Nm



1 Per diode – Pro Diode